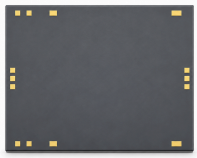
18000–26500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

LCI-PA-18000-26500-PS41T ist ein GaN-MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für 18000–26500 MHz. Er unterstützt CW- und Pulsbetrieb.

PSAT: 41 dBm (typisch); PAE: 26 % (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.



RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	18000	-	26500	MHz
Kleinsignalverstärkung	S21	-	25	-	dB
Welligkeit der Kleinsignalverstärkung	ΔS21	-	±0.4	-	dB
Sättigungsausgangsleistung	Psat	-	41	-	dBm
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	-	26	-	%
Leistungsverstärkung	Gp	-	19	-	dB
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	1.5	-	-
Ausgangs-VSWR	-	-	1.5	-	-
Sättigungsstrom	-	-	2.8	-	A

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung [1]	Vd	-	-	-	22	V
Gatespannung [1]	Vg	-	-	-	-2.1	V
Bias-Strom [2]	-	-	-	-	0.9	A

[1] Wert ohne Kennzeichnung als Minimum, typischer Wert oder Maximum.

[2] Vd = +22 V; Vg = -2.1 V; Wert ohne Kennzeichnung als Minimum, typischer Wert oder Maximum.

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	24	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	27	dBm
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C

Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	4.1 × 3.2 × 0.08	mm

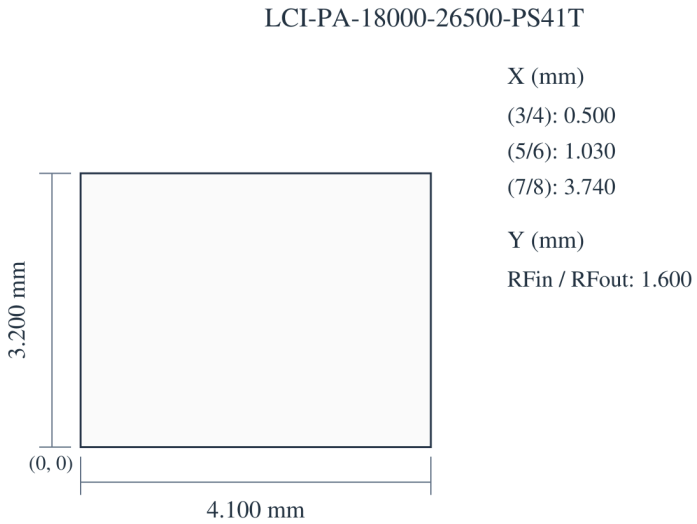
Aktueller Publikationsstand · 1.10 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.9.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Separate Charakterisierung: TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A; τ = 100 µs; D = 10%. Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

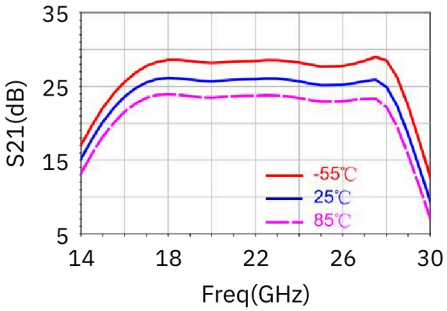


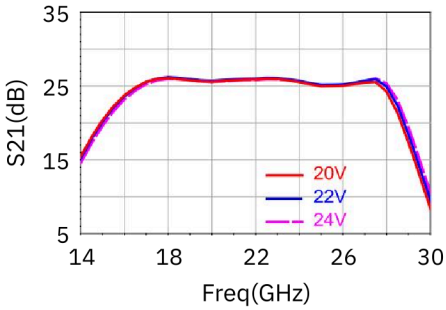
Kennlinien

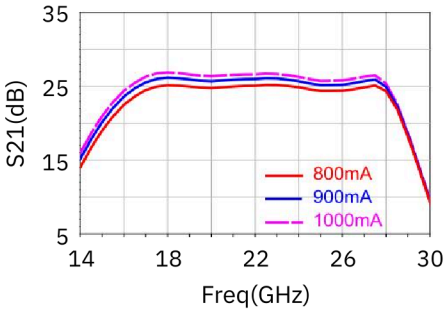
Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

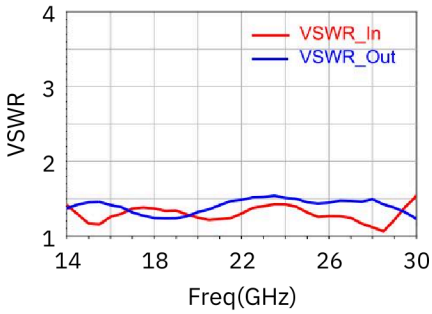
Gepulst — Kleinsignalverstärkung; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung; Ausgangsleistung.

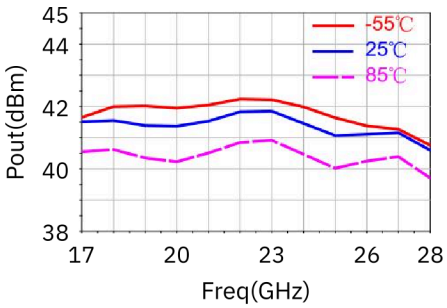
Hinweise zur Abbildung: TA = +25 °C; Vd = 22 V; Id = 900 mA; τ = 100 µs; D = 10%. Beachten Sie die im jeweiligen Diagramm angegebenen Bedingungen jeder Kurve. Pout: Pin = 22 dBm. Die Bedingungen gelten für die angegebenen Teilbilder und deren jeweilige Legenden.

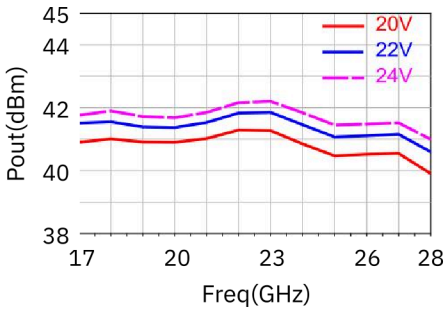






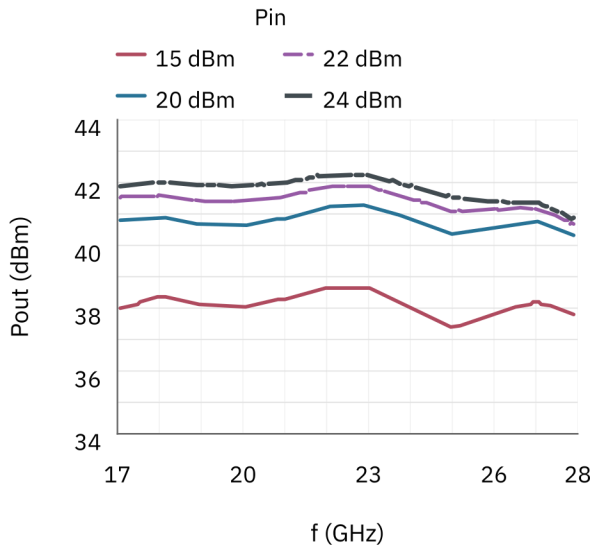


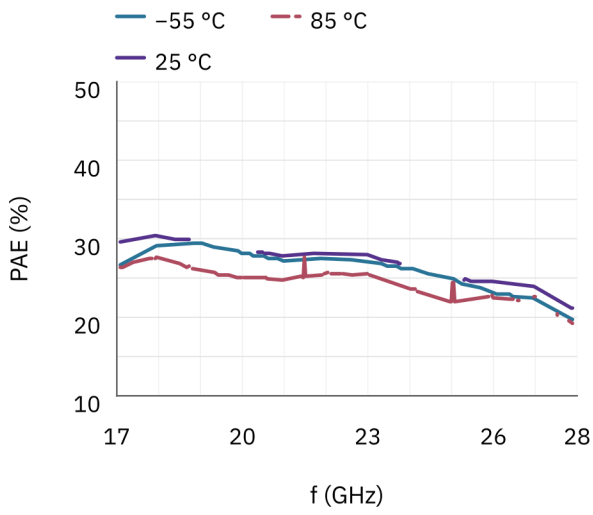




Gepulst — Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz.

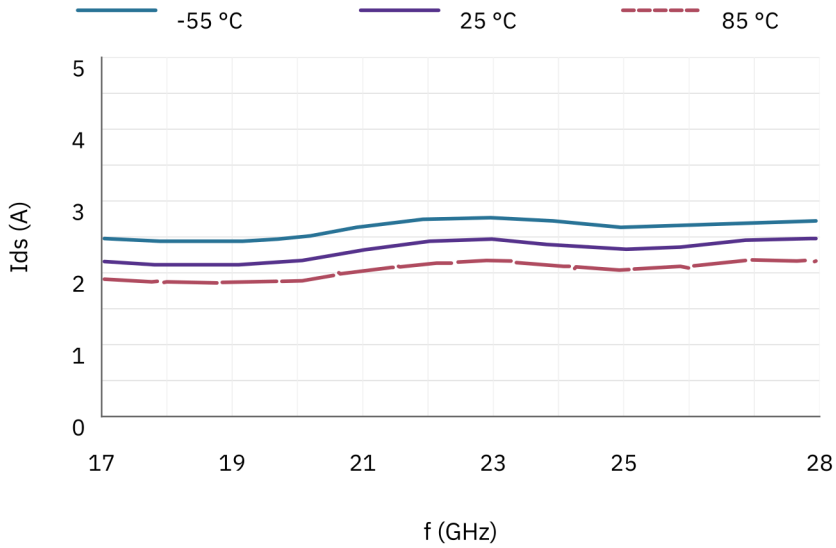
Hinweise zur Abbildung: TA = +25 °C; Vd = 22 V; Id = 900 mA; τ = 100 µs; D = 10%. Beachten Sie die im jeweiligen Diagramm angegebenen Bedingungen jeder Kurve. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Pout: Pin = 15 / 20 / 22 / 24 dBm; TA = +25 °C. PAE: Pin = 22 dBm; T = −55 / +25 / +85 °C. Der Drainstrom Id beträgt 900 mA. Idq ist für dieses Diagramm nicht spezifiziert.





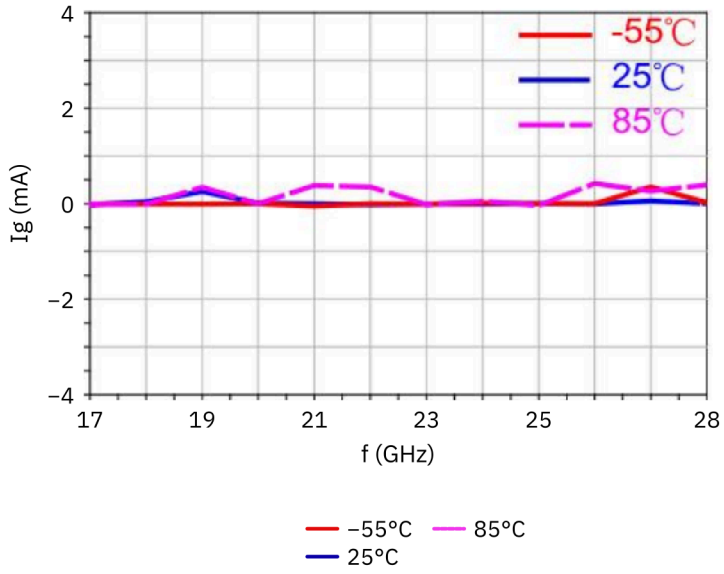
Gepulst — Drainstrom.

Pin = 22 dBm. Hinweise zur Abbildung: TA = +25 °C; Vd = 22 V; Id = 900 mA; τ = 100 µs; D = 10%. Beachten Sie die im jeweiligen Diagramm angegebenen Bedingungen jeder Kurve. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.



Gepulst — Gatestrom.

Pin = 22 dBm. Hinweise zur Abbildung: TA = +25 °C; Vd = 22 V; Id = 900 mA; τ = 100 µs; D = 10%. Beachten Sie die im jeweiligen Diagramm angegebenen Bedingungen jeder Kurve.



Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.